В начало Курсы ФИиВТ 09.03.04 Программная инженерия(Очная) ПС 11 Разработка программных систем 4 семестр

(09.03.04 11 4 сем о)Физика Дополнительные виды работ Вентильный фотоэффект (защита)

Тест начат Вторник, 21 Май 2024, 14:08

Состояние Завершенные

Вторник, 21 Май 2024, 14:15

Прошло 7 мин. 18 сек.
времени

Баллы 3,92/5,00

Оценка 3,13 из 4,00 (78%)

Вопрос 1
Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведите в соответствие выражения, приведенные ниже:

Зоны разрешенных энергий валентных электронов относительно широкие потому, что испытывают...

Зоны разрешенных энергий электронов, близких к ядру, относительно узкие потому, что испытывают...

сильное влияние соседних атомов

слабое влияние соседних атомов

Ваш ответ верный.

Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
На рисунке представлена схема энергетических зон полупроводника <i>p</i> – типа.
A
Буква В обозначает
Выберите один ответ:
уровень Ферми при Т больше 0 К
О валентную зону
О зону проводимости
О акцепторный уровень
уровень Ферми при 0 К ✓
Ваш ответ верный.
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Укажите верные утверждения для полупроводника р-типа:
Выберите один или несколько ответов:
Выберите один или несколько ответов: ☑ Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✔
Выберите один или несколько ответов: ☑ Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✔ Уровень Ферми при T = 0° К находится в середине зоны запрещенных энергий
Выберите один или несколько ответов: ☑ Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✔ Уровень Ферми при T = 0° К находится в середине зоны запрещенных энергий Уровень Ферми при T = 0° К находится между акцепторным уровнем и потолком валентной зоны ✔
Выберите один или несколько ответов: ☑ Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✔ Уровень Ферми при T = 0° К находится в середине зоны запрещенных энергий
Выберите один или несколько ответов: ☑ Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✔ Уровень Ферми при T = 0° К находится в середине зоны запрещенных энергий Уровень Ферми при T = 0° К находится между акцепторным уровнем и потолком валентной зоны ✔
Выберите один или несколько ответов: ☑ Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✔ ☐ Уровень Ферми при T = 0° К находится в середине зоны запрещенных энергий ☑ Уровень Ферми при T = 0° К находится между акцепторным уровнем и потолком валентной зоны ✔ ☐ Энергия активации заряда равна половине энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны
Выберите один или несколько ответов: ☑ Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✔ ☐ Уровень Ферми при T = 0° К находится в середине зоны запрещенных энергий ☑ Уровень Ферми при T = 0° К находится между акцепторным уровнем и потолком валентной зоны ✔ ☐ Энергия активации заряда равна половине энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны
Выберите один или несколько ответов: ☑ Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✔ ☐ Уровень Ферми при T = 0° К находится в середине зоны запрещенных энергий ☑ Уровень Ферми при T = 0° К находится между акцепторным уровнем и потолком валентной зоны ✔ ☐ Энергия активации заряда равна половине энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны

Вопрос **4**Частично правильный
Баллов: 0,25 из 1,00

р-п-переход подключили к внешнему источнику тока, причем "+" присоединили к р-полупроводнику, а "-" к п-полупроводнику.

Укажите последствия такого включения:

Выберите один или несколько ответов:

- тока основных носителей не будет
- уровень Ферми в n-полупроводнике будет ниже, чем в p-полупроводнике
- ✓ уровень Ферми в n-полупроводнике будет выше, чем в p-полупроводнике ✓
- ток основных носителей увеличится
- ✓ ток неосновных носителей увеличится

 ★

Ваш ответ частично правильный.

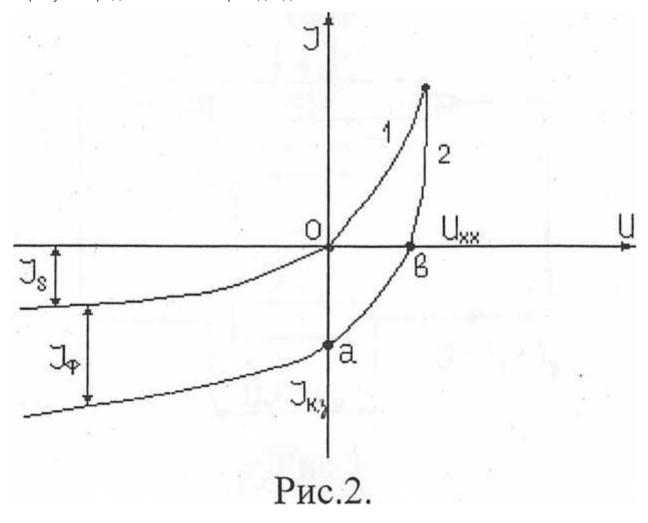
Вы правильно выбрали 1.

Вопрос **5**

Частично правильный

Баллов: 0,67 из 1,00

На рисунке представлена ВАХ фотодиода.



Ток диода между точками а - в обусловлен...

Ток диода левее точки а обусловлен...

Ток диода правее точки в обусловлен...

основными носителями неосновными носителями основными носителями

Ваш ответ частично правильный.

Вы правильно выбрали 2.